

1. 解: 首地址: 即寄存器的基地址的物理地址

$$DS: 021FH \times 10H = 21F0H$$

$$ES: 0A32H \times 10H = 0A320H$$

$$CS: 234EH \times 10H = 234E0H$$

末地址为首地址 + 偏移量 $FFFFH$. 故

$$DS: 21F0H + 0FFFFH = 121EFH$$

$$ES: 0A320H + 0FFFFH = 1A31FH$$

$$CS: 234E0H + 0FFFFH = 334DFH$$

2. 解: 由题知: $(CS) \times 10 + (IP) = 25432H$ 故 $(IP) = 1F52H$

当 $(CS) = 1A31H$ 物理地址为 $(CS) \times 10 + (IP) = 1C262H$

3. 解: 需要保留段基地址和段的偏移地址.

由于 $1A315H$ 为奇数 非规则字, 因此需要 2 个总线周期

读取时 \overline{BHE}/S_1 、 \overline{RD} 、 \overline{DT}/R 为低电平. (\overline{BHE}/S_1 第 1 周期为低, 第 2 个为高)

第 1 总线周期下, 数据通过 $AD_{15} \sim AD_0$ 能送至 $1A315H$ 为地址的字节

第 2 总线周期下, 数据通过 $AD_{15} \sim AD_0$ 能送至 $1A316H$ 为地址的字节

4. 若存储器和 I/O 端口的地址相同时, 可以通过对存储器的访问实现对 I/O 端口的读写.

5. 解: 堆栈操作是字操作.

$(AX) = 1234H$ 为 2 字节, 入栈时 SP 先自减 2, 故物理地址为

$$(SS) \times 10H + (SP - 2) = 10504H$$

总线上: \overline{WR} 、 \overline{BNE} 低电平有效、 M/\overline{IO} 、 DT/R 为高电平有效.